## 位相差回折モアレ信号による超精密位置決め制御

原 憲 司•内 田 悦 行

# Super-Accurate Alignment Technique Using Differential Moire Signals

## Kenji HARA and Yoshiyuki UCHIDA

The demand for high resolution in the lithographic processes is increasing. The submicron lithography requires highly accurate alignment between the mask and the wafer. The authors have proposed an automatic and accurate alignment technique for proximity printing in X-ray lithography using two pairs of moire gratings, respective moire signals from each pair being 180° out of phase with each other. The basic characteristics of diffracted moire signals obtained by some optical basic experiments and numerical calcurations were discussed for the automatic alignment. A control reproducibility better than 32nm was obtained using the stepping moter as an actuator. Experiments for the mask alignment were carried out using two paires of quadruple gratings of 16 $\mu$ m pitch, a combined unit of 4 matched photodiodes and two pairs of PZT controllers. A control reproducibility better than 40nm for X-Y directions was obtained. This technique has been also applied to projection photolithography, as a part of the mix and match lithographic system to go with proximity X-ray lithography.

## 1. はじめに

超 LSI の高密度化に伴って回路パターンの微細 化が進められている。パターンを転写する際のマス ク・ウエハ間の位置決め精度には、パターン最小線 幅の1/5~1/10が要求される。次世代サブミクロンリ ソグラフィプロセスには、数十 nm の位置決め精度 が必要となる。

この高精度位置決めを実現するために,光の干渉 や回折現象を利用した,回折モアレ法,光ヘテロダ イン法,フレネルレンズを用いた方法,など種々の 方法が提案され,装置化の研究が進められてい る<sup>1,2)</sup>。また,マスクパターンの転写に現在使われて いる光縮小投影露光装置では,パターン線幅0.5µm が限界と言われており,さらにパターン線幅が狭く なるとX線を用いた等倍露光方式への移行が必至で あると考えられる。位置決めセンサ技術にもこれに 対応できる高精度が要求される。

モアレ技術を応用した位置決め技術は,位置決め マーク作製の容易な点と,装置が簡素である点から 広く研究されてきた。しかし,モアレ技術を応用し た従来の方法の多くは,回折モアレ光強度が最小と なる点で位置決めを行うために,位置決め感度が低 い。あるいは,±1次回折モアレ光の対称性を利用し たものであるため,位置決めの際の回折光の非対称 性によって影響を受ける。さらに±1次回折モアレ 信号から変位信号とマスク・ウエハ間隙変動信号を 分離することが原理的にできない,などの問題点を もっている。

そこで著者らは、位置決め感度を高めるために回 折モアレ光の強度変化が最大となる点で位置決めを 行う。180°の位相差をもつ2組の回折格子のそれぞ れから得られる0次回折モアレ光の差信号を用いて 自動位置決めを行うため、マスク・ウエハ間隙の微 小変化に影響されず高精度が望める。さらに、ウエ ハマークが、X線等倍露光と光縮小投影露光とに共 用できるハイブリッドリソグラフィに適する。など の特長をもつ位置決め法を提案した。

本論文では、著者らが行ってきたこのモアレ技術



図1 回折モアレ光の計算モデル

(a) 透過形回折モアレ系

(b) 反射形回折モアレ系

を用いた位置決めの方法と今迄に得られた結果を述 べる。まず回折モアレ光の特性を理論計算と実験で 求める。次に,位相差回折モアレ法と名付けた位置 決めの方法について,基本実験で実証する。そして X線等倍露光用マスク位置決め装置の試作結果を示 す。さらにハイブリッド化のために光縮小投影露光 へ適用するための基礎実験を行い,将来への展望を 述べる。

### 2. 回折モアレ光の特性

同一ピッチ P の 2 枚の回折格子を所定の間隔で 配置し、レーザ光を照射すると、その透過光ならび に反射光は各次数に分かれたモアレ編となって現れ る。格子間隔Gを適当に選ぶことにより、0 次の回折 光は格子に垂直方向の相対変位に対してピッチ P の周期で変化する。

回折モアレ光はキルヒホッフの回折理論を用いて計 算できる<sup>3)</sup>。図1に透過と反射の回折モアレ光の計 算モデルを示す。

まず,透過回折モアレ光の計算法について説明する。第1回折格子で回折された光の,第2回折格子 上での複素振幅  $\psi_1$  ( $x_1$ , G) はフレネル回折積分により,次式で与えられる。

$$\psi_{1}(x_{1}, G) = \sum_{m=-M}^{M} \int_{-W_{1}/2}^{W_{1}/2} r^{-1/2} (1+G/r)$$

$$\exp(-ikr) dx_{0} \qquad (1)$$

$$r = [G^{2} + (x_{0} + mP - r_{0})^{2}]^{1/2}$$

ここで, P は回折格子のビッチ, G は格子間隔, k は 波数, 2 M+1 は回折に寄与するスリット数,  $W_1$ は 第1回折格子のスリット幅を示す。

さらに第2回折格子を透過したN次回折光 $f_i$ ( $\Delta x, G_\lambda$ はフラウンホーファ近似を用いて次式で計 算できる。

$$f_{t} (\Delta x, G)_{N} = \int_{-W_{t}/2}^{W_{2}/2} \psi_{1} (x_{1}, G) \\ \exp\left(\frac{2\pi i N x_{1}}{P}\right) dx_{1}$$
(2)

ここで、 $\Delta x$ は2つの回折格子の相対変位、 $W_2$ は第2回折格子のスリット幅を示す。

0次回折光の強度は次式で与えられる。

$$f_{\rm t} \ (\Delta x, G)_0 = \int_{-W_2/2}^{W_2/2} \psi_1 \ (x_1, G) \ \mathrm{d}x_1 \tag{3}$$

次に,第2回折格子が反射形格子である場合の計 算方法について説明する。第2回折格子からの反射 光の第1回折格子背面上での複素振幅は,回折光の 重ね合わせによって計算でき,次式で与えられる。 ψ₂(x₀, G)

$$= \sum_{m=-M}^{M} \int_{-P/2+\Delta x}^{P/2+\Delta x} \psi_1 (x_1, G) R (x_1 - \Delta x)$$

× $r^{-1/2}$  (1+G/r) exp (-ikr) d $x_1$  (4) ここで,反射率分布 R (x) は次のように設定した。

$$R(x) = \begin{cases} 1 & (|x| < W_2/2) \\ \alpha & (W_2/2 < |x| < P/2) \end{cases}$$
(5)

さらに,第1回折格子で回折し戻って行くN次回 折光 $f_r$ ( $\Delta x, G_h$ は,式(2)と同様,フラウンホーファ 近似を用いて次式で与えられる。

 $f_{\rm r}$  (  $\Delta x, G$ )<sub>N</sub>

$$= \int_{-W_1/2}^{W_1/2} \psi_2(x_0, G) \exp\left(\frac{2\pi i N x_0}{P}\right) dx_0$$
(6)

0次回折光強度は次式で与えられる。

$$f_{\rm r} (\Delta x, G)_0 = \int_{-W_1/2}^{W_1/2} \psi_2 (x_0, G) \, \mathrm{d}x_0 \tag{7}$$

透過と反射の 0 次回折モアレ信号の,格子間隔 G を変数とした変位特性の計算結果を図 2 に示す。ここで,透過形では $W_1/P = W_2/P = 0.44$ ,反射形では $W_1/P = 0.44$ ,  $W_2/P = 0.56$ ,  $\alpha = 0.2$ とした。

モアレ信号のコントラストは、2つの回折格子の 間隔を増すとフレネル領域内で周期的に変化し、間 隔が $G=mP^2/\lambda$ で最大となる。ここで、m は整数、





- 図2 格子間隔Gを変数とした0次回折モアレ信号 (数値計算結果)
  - (a) 透過形回折モアレ系(W<sub>1</sub>/P=W<sub>2</sub>/P=0.44)
  - (b) 反射形回折モアレ系( $W_1/P=0.44$ ,  $W_2/P=0.56$ ,  $\alpha=0.2$ )

λ は光の波長である。

これらの特性は、He-Ne レーザを光源とした実験 で確認した。透過と反射の 0 次回折モアレ信号の変 位に対する測定結果を、格子間隔 G を変数として図 3 に示す。回折格子のピッチ  $P=200\mu$ m、使用した He-Ne レーザの波長  $\lambda=0.633\mu$ m である。測定結 果は、数値計算結果(図 2 )とよい一致を示してい る。

#### 3. 位置決め方法

位相差0次回折モアレ信号を用いた自動位置決め の方法<sup>4~6)</sup>を図4を用いて説明する。図4aに2組の 回折格子の位相関係を示す。第1の格子A, Bに対 して第2の格子C, Dはそれぞれ±90<sup>°</sup>位相差をも



- (a) 透過形回折モアレ系 (W<sub>1</sub>/P=W<sub>2</sub>/P=
   0.44)
- (b) 反射形回折モアレ系( $W_1/P=0.44$ ,  $W_2/P=0.56$ ,  $\alpha=0.2$ )

つ、2組の格子A、CおよびB、Dから得られる0 次回折モアレ信号は、格子間隔が $mP^2/\lambda$ において 格子の相対変位に対して図4bに示すように180°の 位相差をもつ。図4aの配置では位置決めの原点で 2つのモアレ信号の強度は等しく、その差信号は0



(b) 180°位相差0次回折モアレ信号

となる。位置決めは2つのモアレ信号の差信号を制 御信号として行う。

本方法では、モアレ信号が位置決め点付近で変位 に対して急傾斜であるので高い位置決め感度が得ら れる。また格子間隔が  $mP^2/\lambda$  からわずか変化して も 2 つの 0 次回折モアレ光の強度の等しい位置決め 点は変化しないなどの特長がある。

#### 4. 透過形位置決め実験

透過回折格子を用いる位相差 0 次回折モアレ法に よる位置決めの基本実験システムを図 5 に示す。 He-Ne レーザ光を、半透鏡により 2 光束に分け、2 組の回折格子A, CおよびB, Dに入射する。回折 格子のピッチは200 $\mu$ m である。格子A, Bは一体の 格子であり、格子C, Dは分離した格子である。格 子C, D間の180°の位相差は、格子Dを載せたXY補 助微動台のX軸方向の調整で行う。格子A, BとC, Dの間隙は、移動用微動台のY軸方向の調整によっ て1 mm に設定した。ステッピングモータのギア比 は1/180で、ステップ角は0.01°である。この角度に対 応した移動用微動台X軸方向の最小変位は0.028  $\mu$ m である。2 組の格子からの 0 次回折モアレ光は 2つのフォトダイオードで受光し、前置増幅器によ



図5 透過形位置決め実験システム

って増幅する。2つの検出出力のコントラストが等 しくなるように、片方の光路に入れてある減光器と 2台の前置増幅器の利得を調節する。コントラスト の等しくなった2つのモアレ検出信号は、差動増幅 器に取り込まれる。差動増幅器からの出力ノイズは、 時定数可変の RC フィルタで低減する。差動増幅器 の出力電圧は、回折格子の相対変位に対して正・負 に変化し、位置決め点において0となる。

差動増幅器の出力電圧は、2つのコンパレータに より,正・負の設定電圧と比較される。このコンパ レータの出力により,移動用微動台のステッピング モータの駆動が制御される。差動増幅器の出力電圧 が正の設定電圧より大きいと、これに対応するコン パレータの出力がハイレベルとなり、もう一方のコ ンパレータの出力はローレベルとなる。このために, 駆動回路にパルスが入っていればステッピングモー タは時計方向に回転する。差動増幅器の出力電圧が 負の設定電圧よりも振幅が大きいと, 逆にステッピ ングモータは反時計方向に回転する。しかし、どち らの場合も OR ゲートの出力はハイレベルである。 従って, AND ゲートにより駆動回路にパルスが入 り、ステッピングモータは回転を続ける。差動増幅 器の出力電圧がコンパレータの設定電圧の範囲内に あると、両方のコンパレータの出力はローレベルと なり, OR ゲートの出力もローレベルとなる。従っ て,ANDゲートはステッピングモータの駆動回路 にパルスが入ることを制止し, ステッピングモータ は差動増幅器の出力電圧が0となった位置の近傍で 止まる。このように、コンパレータの設定電圧の値 は、このシステムの不感帯幅すなわち位置決め精度 を決める。



#### 5. 透過形位置決め実験結果

移動用微動台のステッピングモータをX軸方向に 連続動作させた時の0次回折モアレ信号および差動 増幅器の出力をそれぞれ、図6a, bに示す。モア レ信号は格子ピッチ  $P=200\mu$ mの周期で変わり、2 信号は180°の位相差を示している。ここで、 $P_0$ をロッ ク位置とすると、2つのモアレ信号が等しい偶数番 目の点  $P_{\pm 2}$ ,  $P_{\pm 4}$ , …でもロックが可能である。しか し、奇数番目の点  $P_{\pm 1}$ ,  $P_{\pm 3}$ , …ではロックされない。 これは、ステッピングモータが、差動増幅器の出力 電圧が正の場合には時計方向に、負の場合には反時 計方向に回転するためである。コンパレータの設定 電圧の極性を反転すれば、逆に  $P_{\pm 1}$ ,  $P_{\pm 3}$ , …でロッ クされる。従って位置決め領域は、位置決め点の両



側 $\pm P/2 = 100 \mu m$  である。

モアレ信号による自動位置決めの様子を図7に示 す。まず、制御ループのスイッチを切り手動により 変位を作る。この変位点を出発点として制御ループ のスイッチを入れ位置決めを自動的に行わせる。そ の際の2つのモアレ信号の変化の様子を図7aに、 対応する差動増幅器の出力電圧を図7bにそれぞれ 示す。図6のP<sub>0</sub>点を位置決め点とし、手動でこの位 置決め点から±10 $\mu$ m離れた点と、±90 $\mu$ m離れた P<sub>±1</sub>点近傍の点を出発点とした。位置決め点近傍か らも、モアレ信号のピーク1つ隔てた点からも、同 じP<sub>0</sub>点にロックされる。









図 9 自動位置決め信号の記録 破線は不感帯領域±16nm

モアレ信号が変位に対して正弦波で変化し、位置 決め点がその直線域であるので, 近似的にコンパレ ータの設定電圧に対する変位が求まる。

$$\Delta I = \frac{P}{2\pi} \frac{I_{ref}}{I_{max}}$$

ここで、 $I_{ref}$ は設定電圧の大きさ、 $I_{max}$ は2つのモア レ信号の差信号の最大振幅値である。実験で設定し たコンパレータの設定電圧±50mV は±0.08µmの 変位に相当し、この不感帯幅内にロックされた。

#### 6. 反射形位置決め実験

実際のリソグラフィプロセスでは、第2格子は反 射率の高いウエハ上に描かれることになる。従って, 第1格子に透過回折格子,第2格子に反射回折格子 を用いた反射形位置決めシステムとなる。

図8に示す実験配置で反射形の位置決め実験を行 った<sup>7,8)</sup>。この実験では、回折格子A、CおよびB、 Dから得られた180°位相の異なった2つの0次回折



モアレ信号をマイクロコンピュータへ取り組み、2 信号の差を取り出すための演算とステッピングモー タの制御をマイクロコンピュータで行った。ここで は、ピッチ25µm、デューティ比1/2の矩形格子を用 いた。He-Ne レーザ光の波長は0.633µm である。格 子C、D間には180°の空間的な位相差を生じさせた。 回折格子の間隔は、移動用微動台のY方向の調整に よって1 mm に設定した。移動用微動台のX方向1 ステップ最小変位は14nm である。前置増幅器のノ イズ低減用 RC フィルタの時定数は0.4s である。

図9に、反射形での位置決め実験結果の一例を示 す。2本の破線は、正・負の設定値を示し、この不 感帯幅は±16nmに相当する。システムの発振を回 避するために、コンピュータは移動用微動台をステ ッピングモータを介して移動させた後, 1.4sの待ち 時間後に AD コンバータから信号を読み取る。この 待ち時間は RC フィルタの時定数の3倍以上であ る。図10に、位置決め点の度数分布を示す。ロック 位置をX軸に、頻度をY軸に示す。ロック実験の試 行回数は100である。すべてのロック位置は、設定値 に対応した不感帯幅±16nmの範囲内に入り、一様 に分布している。

#### 7. マスク位置決め装置への適用

上記の実験結果から、本技術が位置決めシステム に適用できると言える。しかし、本技術を実際の位 置決め装置に適用し、精度5 nm で設計するために は、ステージの分解能、システムの S/N や安定性を 改善する必要がある。

ステッピングモータのかわりに, PZT 圧電積層体 駆動機構を用いると、分解能が向上し応答速度の改 善も期待できる。図11に示すマスク精密位置決め用 PZT 圧 電 積 層 体 駆 動 XYO ス テ ー ジ を 試 作 し た<sup>9,10)</sup>。各頂点に2個の PZT 素子と2個の押しばね



**図11** PZT 圧電積層体駆動 XY<sub>O</sub> ステージ



図12 4 分割回折格子

が直角に配置されており, PZT 素子と押しばねが押 し合うような構造になっている。この PZT 素子に 印加する電圧を制御すれば, XYOの3自由度を高 分解能で制御できる。例えば, PZT 素子Aの印加電 圧を上げ, Cの印加電圧を下げると, ステージはX 方向に移動する。同様に, PZT 素子BとDにより, Y方向に移動する。また, PZT 素子AとCの両方の 印加電圧を上げると, O方向の回転制御が行える。

この PZT 圧電積層体駆動 XY $\Theta$  ステージの位置 決め制御には、図12 a に示すような4分割回折格子 を図11のステージ上2ヶ所に配置する。これらの格 子を用いれば、直交する2方向ならびに回転を同時 に制御できる。4分割格子の大きさは、10×10mm<sup>2</sup> である。図12は模式的に描いてあるが、実際の格子 ピッチは16 $\mu$ m である。回折格子 X<sub>A</sub>と X<sub>c</sub>、 X<sub>B</sub>と X<sub>D</sub>, Y<sub>A</sub>と Y<sub>c</sub>, Y<sub>B</sub>と Y<sub>D</sub>がそれぞれ対応するように 第1,第2格子を配置する。また格子対 X<sub>A</sub> X<sub>c</sub>と X<sub>B</sub> X<sub>D</sub>は空間的な位相が180°異なっており、X方向の位



**図13** PZT 圧電積層体駆動マスク位置決めシステ ム

置決めに利用する。同様に、 $Y_A Y_c \ge Y_B Y_D$ はY 方向の位置決めに用いる。

図13に示すような、PZT 圧電積層体駆動 XYの ス テージと4分割格子を組み合わせた位置決めシステ ムを構成し、位置決め実験を行った。He-Ne レーザ 光は、第1および第2格子に入射する。第1格子は 試作した PZT 圧電積層体駆動 XY® ステージに、第 2格子はXY ステージに設置されている。4分割格 子からの0次反射モアレ信号は、1素子4分割フォ トダイオードで受光され、電気信号に変換される。 信号は前置増幅器で増幅された後, AD コンバータ によりデジタル信号に変換され、マイクロコンピュ ータに入力される。マイクロコンピュータはこれら の信号をもとにして、DA コンバータを介して PZT 圧電積層体駆動 XYΘ ステージを制御し位置決めを 行う。AD および DA コンバータに12bit を用いた。 PZT 圧電積層体駆動回路の出力レンジは20~500V である。

図14に, PZT 圧電積層体駆動 XYO ステージをX 方向およびY方向に移動させて得られたモアレ信号 を示す。横軸に PZT 素子の印加電圧,縦軸に信号強 度を示す。波形が非対称になっているのは調整不良 と PZT 素子のヒステリシスによるものであり,フ ィードバック制御を行う本システムでは問題となら ない。

図15に, XY 2軸について位置決めを行った結果 を示す。横軸に時間,縦軸にモアレ差信号から換算 した PZT 圧電積層体駆動 XY® ステージの変位を 示す。2本の破線は正・負の設定値で,この領域に



入るよう制御を行っている。設定値により決まる不 感帯幅は±20nm である。実線はX方向,破線はY方 向の制御信号である。X方向とY方向間に相互干渉 があり,一方向ずつ順次領域を狭くする方法で位置 決めを行った。

PZT 圧電積層体駆動 XYO ステージでの基本実 験では、±20nm の精度が得られたが、さらに XY ス テージの高剛性化とシステムの安定性の向上などは 残された問題である。

#### 8. 縮小投影露光装置への応用

半導体リソグラフィプロセスの高密度化は、光縮 小投影露光、光縮小投影露光とX線等倍露光の双方 を組み合わせたハイブリッド露光、そしてX線等倍 露光と順次進められる現状である。従って、位置決 めシステムも等倍露光(プロキシミティ方式)と光 縮小投影露光(プロジェクション方式)の双方に適 用できるものが有利である。位相差回折モアレ法を 光縮小投影露光装置に適用する投影モアレ位置決め 実験を行った<sup>11)</sup>。図16に示す光学配置で投影モアレ 光を測定した。第1格子G<sub>1</sub>に125 $\mu$ m ピッチ、第2格 子G<sub>2</sub>に25 $\mu$ m ピッチの格子を用い、1/5縮小レンズ により、G<sub>1</sub>の格子像をG<sub>2</sub>の格子上に重ね合わせる。



図15 XY自動位置決め信号の記録



図16 投影モアレ光学系



レーザ光の入射位置とモアレ光検出位置が異なる 図16a, b, cの光学系配置でモアレ光を第1格子 G<sub>1</sub>の変位に対して観測した。図17に図16aの光学系 配置で得られた反射形投影モアレ信号の測定結果を 示す。横軸はG1の投影像とG2との相対変位,縦軸は モアレ信号である。結果はプロキシミティ方式の透 過形回折モアレ信号と類似の特性を示している。図 16bの光学系配置においても同様の特性を示すが, 図16cの光学系配置ではプロキシミティ方式での反 射形回折モアレ信号と類似の特性を示す。いずれの 場合にも位置決めに有用なモアレ信号が検出されて いる。

現在,本技術を実際の光縮小投影露光装置に組み 込み,実装技術として問題の解決が図られてい る<sup>12,13)</sup>。露光用光源と位置決め用光源の波長が異な ることによる位置決め精度への影響,位置決め速度 の高速化など研究課題はまだ残されている。

#### 9. おわりに

- (1) 回折モアレ光の数値計算結果と実験結果とが良い一致を示した。
- (2) 180°の位相差をもつ2組の回折格子を用いる と、0次の回折モアレ信号の差動信号で自動位置 決め制御ができることを示した。
- (3) 回折格子を近接配置(プロキシミティ)して、 透過形および反射形の0次回折モアレ信号による 位置決め実験を行いこの技術の有効性を実証した。
- (4) X線等倍露光用圧電積層体駆動 XYO マスク位 置決めステージで±20nmの位置決め精度が得ら れた。
- (5) 光縮小投影露光装置の位置決めにも位相差回折 モアレ法が適用可能であることを実験で示した。
- (6) 位相差回折モアレ法を用いた超精密位置決め技 術がハイブリッド露光装置に有用であることを示 した。

#### 謝辞

リソグラフィ用アライメントに関する一連の研究 を、名古屋大学工学部電子機械工学科工学博士服部 秀三教授の指導で1983年から始めた。参考文献の著 者ら共同研究者の協力に対して謝意を表す。数値計 算の一部に本学計算センターのスーパーコンピュー タ CRAY X-MP14se を用いた。超精密光学実験の 一部は本学クリーンルーム設備クラス1000で行われ た。

## 参考文献

- 内田悦行,肥後村誠,大橋康二:超精密位置決め用センサの事例,昭和63年度精密工学会春季 大会シンポジウム資料,83-87,1988.
- 2)内田悦行,原憲司:いま注目される超精密位置 決め用センサ,回折モアレ法,光ヘテロダイン 法,フレネルレンズ法:M&E,15,108-115, 1988.
- V. T. Chitnis, Y. Uchida, K. Hane and S. Hattori: Moire Signals in Reflection, Opt, Commun., 54, 207-211, 1985.
- 4)服部秀三,内田悦行,V.T.Chitnis:モアレ干 渉法を用いた超精密自動位置決め技術,精密機 械,51,135-140,1985.
- 5) S. Hattori, Y. Uchida and V. T. Chitnis: An Automatic Super-Accurate Positioning Technique Using Moire Interference, Bull. Jpn. Soc. Prec. Eng., 20, 73-78, 1986.
- S. Hattori and Y. Uchida: Optical Self-Alignment System, U.S.Pat., 4664524, 1987.
- Y. Uchida, M. Furukawa, K. Hane and S. Hattori: Automatic Alignment Technique for X-ray Lithography Using Moire Signals in Reflection, SPIE, 661, 95-101, 1986.
- Y. Uchida, S. Hattori and T. Nomura : An Automatic Mask Alignment Technique Using Moire Interference, J. Vac. Sci. Technol., B5, 244-247, 1987.
- 9) Y. Uchida, Y. Akao, H. Miyake, T. Iida, M. Furukawa, K. Hane and S. Hattori : Microcomputer Controlled Positioning System Using Moire Signals, Digest of 1987 Int. Conf. on Lasers, (Xiamen, PRC) 150, 1987.
- 10) H. Miyake, T. Iida, K. Miwa, T. Shibata, A. Yoshida, Y. Uchida and S. Hattori: Automatic Mask Inspection System Using X-Ray as a Source, SPIE's 1989 Symp. on Microlithography, (San Jose, USA) 1089-20, 1989 (accepted).
- Y. Uchida, K. Hara, T. Nomura, S. Kimura, D. Sugimoto, A. Yoshida, H. Miyake, T. Iida and S. Hattori: An Alignment Technique Using Diffracted Moire Signals, 33rd Int.

Symp. on EIPB, (Monterey, USA) 1989 (communicated).

- 12) T. Nomura, S. Kimura, Y. Uchida and S. Hattori : Moire Alignment Technique for the Mix and Match Lithographic System, J. Vac. Sci. Technol., B6, 394-398, 1988.
- D. Sugimoto, S. Kimura, T. Nomura, Y. Uchida and S. Hattori : Moire Alignment Technique for Projection Photolithographic System, SPIE's 1989 Symp. on Microlithography, (San Jose, USA) 1088-26, 1989 (accepted).

(受理 平成元年1月25日)